

Тематический указатель статей, опубликованных в 2008 году

Фундаментальные исследования

- Горбацевич А.А., Журавлев М.В., Капаев В.В.* Квазибезотражательные потенциалы в полупроводниковых наногетероструктурах. № 2, с. 3.
- Коноплев Б.Г., Рындин Е.А.* Исследование транспорта носителей заряда в связанных квантовых областях. № 2, с. 14.
- Лавров И.В.* Теория электропроводности неоднородных материалов с текстурой. № 1, с. 3.
- Морозова Н.К., Мидерос Д.А.* Связанный экситон на SA и SAL центрах ZnS(O) и ZnSe(O). № 3, с. 3.

Материалы электронной техники

- Аевров Д.Д., Дорожкин С.И., Таиров Ю.М., Фадеев А.Ю., Лебедев А.О.* О включениях углерода при выращивании слитков карбида кремния модифицированным методом Лэли. № 2, с. 23.
- Аль-Хадрами И.С., Королев А.Н., Семенистая Т.В., Назарова Т.Н., Петров В.В.* Исследование газочувствительных свойств медьсодержащего полиакрилонитрила. № 1, с. 20.
- Варавин В.С., Сидоров Г.Ю.* Образование акцепторных центров при воздействии окислительно-восстановительных сред на поверхность пленок $Cd_xHg_{1-x}Te$. № 5, с. 3.
- Вигдорович Е.Н.* Термодинамические аспекты формирования квантоворазмерных гетероструктур на основе GaN. № 3, с. 18.
- Вигдорович Е.Н., Свешников Ю.Н.* Получение квантово-размерных гетероструктур на основе GaN. № 4, с. 3.
- Грибов Б.Г., Зиновьев К.В.* Новые технологии получения поликристаллического кремния для солнечной энергетики. № 3, с. 10.
- Димитрюк А.А., Одуев В.В.* Комплексная магнитная проницаемость ферритовых материалов СВЧ-диапазона. № 2, с. 32.
- Ермошин И.Г., Цыпленков И.Н., Свешников Ю.Н.* Оптимизация технологии получения гетероструктур GaN с использованием данных дифрактометрического анализа. № 2, с. 49.
- Неустроев С.А.* Модель структуры вюрцитных и кубических нитридов металлов IIIa группы. № 3, с. 26.
- Осипенкова Н.Г., Шутова Р.Ф., Козлова Е.Е.* Исследование состава материалов на основе функциональных стекол для изготовления толстопленочных терморезистивных датчиков. № 2, с. 43.
- Поголов А.И., Грушевский А.М., Долговых Ю.Г., Сурин Ю.В., Виговская Т.В., Бычкова В.С.* Исследование напряженно-деформированного состояния материалов герметизированной сборочной конструкции СВЧ МДП-диодов. № 6, с. 8.
- Руднев А.В., Хлынов А.В.* Использование сканирующей зондовой микроскопии в исследованиях электроосаждения меди на платине в присутствии органической добавки. № 6, с. 15.
- Светличная Л.А., Милешко Л.П., Королев А.Н.* Электрофизические свойства анодных пленок хлорсодержащего Cu_2O на стеклотекстолите. № 2, с. 39.
- Хабибуллин И.Х., Шмидт Е.В., Матухин В.Л.* Исследование электронных и магнитных свойств полупроводникового соединения $CuFeS_2$ в диапазоне температур 77-300 К. № 6, с. 3.
- Яременко Н.Г., Карачевцева М.В., Страхов В.А., Галиев Г.Б., Мокеров В.Г.* Фотолюминесценция эпитаксиальных слоев GaAs, легированных кремнием. № 1, с. 10.

Технология микроэлектроники

Беспалов В.А., Овчинников В.А., Базанов Д.В., Аваков С.М. Методы устранения дефектов топологии интегральных микросхем на фотошаблонах. № 6, с. 20.

Вишиницкий А.Ф., Грушевский А.М., Ларионов Н.М., Погалов А.И., Резник А.Ю. Исследование и моделирование термостойкости пластиковых бесконтактных идентификационных карт. № 5, с. 18.

Гаврилов С.В., Гудкова О.Н., Каграманян Э.Р. Анализ надежности функционирования цифровых КМОП СБИС с учетом эффектов деградации транзисторов. № 6, с. 30.

Овчинников В.А. Исследование технологического процесса устранения прозрачных дефектов маскирующего покрытия фотошаблонов. № 5, с. 11.

Микроэлектронные приборы и системы

Алексеев Ю.И., Демьяненко А.В. Определение влияния оптического сигнала на импедансные свойства лавинно-пролетного диода. № 3, с. 58.

Бобрешов А.М., Хребтов И.В., Ряполов М.П. Влияние конструктивных параметров субмикронных НЕМТ-транзисторов на верхнюю границу динамического диапазона линейности усилителей. № 3, с. 32.

Гуминов Н.В., Старосельский В.И. Прецизионный истоковый повторитель с малым входным током на полевых транзисторах с управляющим барьерным контактом. № 1, с. 43.

Игнатьева Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Расчет конструктивных параметров и электрического потенциала трехдиодной вертикально интегрированной спектрально-селективной фотоячейки. № 1, с. 35.

Кацоев Л.В., Кацоев В.В., Ильичев Э.А. Оптимизация структуры детекторов на основе арсенида галлия с учетом рекомбинационных потерь. № 3, с. 52.

Лосев В.В. Инжекционные фотодиоды на основе низкоомных монокристаллов ZnS. № 4, с. 17.

Мальцев А.В. Особенности движения заряженных частиц в ВЧ-поле при амплитудной модуляции питающего напряжения квадрупольного фильтра масс. № 4, с. 22.

Нисков В.Я., Золотарев С.Н., Гашков А.Н. Исследование влияния конструктивно-технологических факторов на проводимость и пробивное напряжение латеральных ДМОП-транзисторов средствами численного моделирования. № 3, с. 45.

Тимошенков В.П., Братов В.А. Преобразователь кодов NRZ в NRZM на арсенидгаллиевых гетеропереходных биполярных транзисторах. № 1, с. 26.

Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Куликов М.Ю. Фотонные структуры и их использование для измерения параметров материалов. № 5, с. 25.

Хайновский В.И., Игнатьева Е.А., Уздовский В.В. Анализ процессов фоторелаксации и фотоэлектрических характеристик трехдиодной вертикально интегрированной спектрально-селективной фотоячейки. № 3, с. 38.

Хайновский В.И., Игнатьева Е.А., Уздовский В.В. Фотоэлектрические процессы в пятидиодной вертикально интегрированной спектрально-селективной фотоячейке. № 4, с. 10.

Чаплыгин Ю.А., Артамонова Е.А., Красюков А.Ю., Крупкина Т.Ю. Исследование тепловых эффектов и явлений саморазогрева в планарных силовых МОП-транзисторах КНИ-типа. № 2, с. 52.

Нанотехнология

Агеева С.А., Бобринецкий И.И., Неволин В.К., Подгаецкий В.М., Селищев С.В., Симунин М.М., Конов В.И., Савранский В.В. Объемный альбуминовый композит на основе нанотрубок, получаемый действием непрерывного лазерного излучения. № 5, с. 33.

Максимов С.К., Максимов К.С. Проблемы текстурированности в нанотехнологии. Контроль текстур. № 1, с. 49.

Царик К.А., Лосев В.В., Бараиш С.В. Формирование нанометровых слоев фокусированным ионным пучком. № 3, с. 63.

Схемотехника и проектирование

Булах Д.А. Применение компиляционного подхода к моделированию аналоговых схем. № 4, с. 26.

Кремлев В.Я., Крупкина Т.Ю., Николаев А.В. Построение цифровых схем на основе элементов конденсаторно-транзисторного типа. № 1, с. 56.

Крупкина Т.Ю., Лосев В.В., Муханюк Н.Н., Путря М.Г. Автоматизация проектирования библиотек стандартных элементов на основе параметризованных ячеек в САПР Cadence. № 4, с. 31.

Латников Д.С., Миропольский М.С. Аналоговая ячейка коммутации к тестовой шине для измерения внутренних сигналов интегральных микросхем. № 5, с. 51.

Стемпковский А.Л., Гаврилов С.В., Каграманян Э.Р. Методы логико-временного анализа заказных блоков СБИС. № 5, с. 41.

Микросистемы

Борисов А.Г., Маханько Е.С., Чиликина Т.Д., Иванова О.М., Крутоверцев С.А. Газовый оптический сенсор на основе планарного многомодового волновода. № 2, с. 61.

Бритов А.Д., Белоконев В.М., Надеждинский А.И., Наместников Д.Ю., Понуровский Я.Я. Лазерный детектор дистанционного обнаружения газов CO₂, CH₄ и NH₃. № 2, с. 65.

Тимошенков С.П., Шилов В.Ф., Бойко А.Н., Симонов Б.М. Исследование влияния газового демпфирования на параметры микроакселерометров. № 2, с. 58.

Информационные технологии

Автушенко К.И. Алгоритм обнаружения сердечного ритма плода в доплеровском сигнале. № 3, с. 77.

Александров А.А., Коплович Е.А., Умняшкин С.В. Алгоритм видеокompрессии на основе дискретного вейвлет-преобразования с трехслойной схемой кодирования векторов движения. № 5, с. 69.

Земсков В.Н., Бегишев С.В. Кодирование с предсказанием в модифицированной системе сжатия методом ДИКМ. № 2, с. 78.

Колдаев В.Д. Эвристические и квазитопологические алгоритмы контурной сегментации изображений. № 6, с. 41.

Кучинский А.С., Путря Ф.М. Симулятор многоядерной вычислительной системы и примеры его применения. № 2, с. 72.

Лупин С.А., Шерина Е.В., Пономарева Н.Ю. Формализация процессов интеграции информационных систем на основе теории множеств. № 3, с. 68.

Назаров Л.Е., Головкин И.В. Оценки вероятностей ошибки при посимвольном приеме ансамблей ортогональных и симплексных сигналов. № 5, с. 63.

Парфененко А.С., Рыбачек А.В., Рыбалко Е.С. Особенности функционирования и применений ассоциативной памяти. № 6, с. 46.

Переверзев А.Л. Аппаратная реализация одномерного медианного фильтра с модульной архитектурой. № 1, с. 68.

Слюсарь В.В., Баин А.М., Со Тант Методика автоматизированного анализа документированной информации в системах поддержки принятия решений. № 3, с. 81.

Терентьев А.И. Идентификация параметров функционирования сложных технических систем на основе априорной информации и результатов испытаний. № 5, с. 56.

Четверик В.Н. Дифференциальный радиоконтраст в задачах оценки качества радиолокационных изображений. № 1, с. 62.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Алексеев В.Е., Савченко Ю.В., Соловьев А.Н. Проблемы построения фильтра Калмана в многоантенной системе на основе спутниковых сигналов GPS/GLONASS. № 6, с. 58.

Орешкин В.И., Лялин К.С., Чиркунова Ж.В. Особенности проектирования цифровых антенных решеток. № 4, с. 36.

Садков В.Д., Уткин В.Н. Разработка чип-аттенюатора для поверхностного монтажа на основе распределенных резистивных структур. № 4, с. 42.

Чиркунова Ж.В., Лялин К.С., Орешкин В.И. Исследование алгоритма множественного доступа с пространственным разделением каналов в системе с цифровой антенной решеткой. № 6, с. 52.

Методы и техника измерений

Бурдинский И.Н. Применение программируемой матричной логики для корреляционной обработки шумоподобных гидроакустических сигналов. № 4, с. 62.

Вернер В.Д., Гайдуков Г.Н., Пагин П.С. Исследование влияния модификации поверхности микрорезонаторов на их частотные свойства. № 4, с. 55.

Кострицкий С.М., Дикевич А.А., Коркишко Ю.Н., Фёдоров В.А. Метод измерения точки росы, основанный на эффекте изменения коэффициента отражения от скола волокна. № 5, с. 74.

Максимов С.К. Особенности, методика и преимущества интегрального метода исследования текстур наноразмерных кристаллитов в электронной микроскопии. I. Физические основы метода. № 3, с. 85.

Максимов С.К. Особенности, методика и преимущества интегрального метода исследования текстур наноразмерных кристаллитов в электронной микроскопии. II. Практическая реализация метода. № 4, с. 47.

Терещенко С.А., Потапов Д.А., Скоринкин И.С. Исследование прохождения оптического излучения через многослойные рассеивающие среды в приближении «рассеяние прямо назад». № 5, с. 79.

Филатов А.Л., Луговской А.В. Использование фоторефрактивного эффекта для комплексного трехмерного локального измерения электрофизических и термических параметров кремниевых структур. № 1, с. 74.

Филатов А.Л., Герус А.В., Кораблев Е.М., Луговской А.В. Локальное измерение электрооптических параметров кремниевых структур на основе фоторефрактивного эффекта. № 6, с. 66.

Хаханина Т.И., Гурская А.А. Применение инверсионной вольтамперометрии для контроля содержания микропримесей в синтетическом сапфире. № 1, с. 79.

Проблемы высшего образования

- Акуленок М.В., Коринтели Н.З., Сиврюкова Ю.Ю.* О роли компетентностного подхода в обеспечении качества профессионального образования. № 2, с. 85.
- Григорьев В.К., Грушин А.В.* Методика автоматизированной обработки зачетно-экзаменационных ведомостей в полнофункциональной ИУС «Деканат». № 6, с. 71.
- Мязина Р.А.* Особенности формирования готовности студентов к использованию информационных компьютерных технологий в свете компетентностного подхода. № 2, с. 90.

Краткие сообщения

- Батырев Е.В., Тхейн Лин У* Лепестковый датчик угловых координат солнечной энергетической установки. № 4, с. 72.
- Беневоленский С.Б., Истомина Н.Л., Смирнова А.А., Спыну М.В.* Программный комплекс для систем дифрактометрического контроля и измерения геометрических параметров элементов топологии ИМС. № 6, с. 83.
- Бец В.П., Ковтонюк А.В., Кантор А.В., Невзоров А.В., Шишаков А.Е.* Телеметрическая система сбора и регистрации данных макета спускаемого аппарата космического аппарата «Фобос-Грунт» для обеспечения полигонных испытаний. № 6, с. 81.
- Бирюков В.Н.* Четырехпараметрическая S_{∞} -непрерывная компактная модель полевого транзистора. № 4, с. 69.
- Бобринецкий И.И., Лосев В.В.* Емкостная методика сканирующей зондовой микроскопии в атмосфере воздуха. № 6, с. 85.
- Гулидов Д.Н., Бородин Е.В., Селезнев К.А., Ивченко В.Н.* Функционально-итерационное проектирование СМК, соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001:2001. № 1, с. 84.
- Гуреев А.В., Воронин С.Е.* Генератор гауссовских импульсов для сверхширокополосных приемопередатчиков. № 4, с. 74.
- Ездаков А.Л.* Объектно-ориентированная диагностическая экспертная система «МАЛЭКС». № 4, с. 78.
- Ефимов А.Г., Панин В.Ф.* Полосно-пропускающие фильтры на диэлектрических резонаторах с высокой проницаемостью. № 6, с. 79.
- Милешко Л.П.* Влияние режима формирования анодных оксидных пленок кремния в гальваностатическом режиме на содержание в них фосфора. № 4, с. 68.
- Сергеев В.А., Дулов О.А., Куликов А.А.* Компьютерное моделирование неизотермического токораспределения в симметричных биполярных транзисторных структурах с дефектами. № 5, с. 86.
- Соколов Е.Б., Батюня Л.П.* Получение пленок нитрида бора методом ВЧ-магнетронного распыления. № 5, с. 84.
- Трояновский В.М.* Компьютерное моделирование процедур идентификации динамических объектов. № 4, с. 76.
- Уткин В.Н., Садков В.Д., Якимов Д.Ю.* Расчет Т-образных поглощающих элементов чип-аттенуаторов для поверхностного монтажа. № 1, с. 86.

Юбилей

- Арменскому Егению Викторовичу - 85 лет. № 5, с. 91.
- Бархоткину Вячеславу Александровичу – 70 лет. № 1, с. 91.
- К 90-летию со дня рождения Гуськова Геннадия Яковлевича. № 5, с. 92.
- Копяеву Юрию Васильевичу – 70 лет. № 1, с. 89.
- Королеву Михаилу Александровичу – 75 лет. № 2, с. 94.

95 лет со дня рождения Курбатова Леонида Николаевича. № 1, с. 93.

К 100-летию со дня рождения Лукина Федора Викторовича. № 4, с. 95.

Орликовскому Александру Александровичу - 70 лет. № 4, с. 90.

К 90-летию со дня рождения Преснухина Леонида Николаевича. № 4, с. 92.

Конференции. Семинары. Выставки

Вторая Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информатизации. Развитие информационной инфраструктуры, технологий и систем». № 6, с. 88.

15-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2008». № 1, 4-я стр. обложки.

II Московская межвузовская научно-практическая конференция «Студенческая наука». № 1, с. 25.

Российско-Баварская конференция по биомедицинской технике (RBC-2008). № 3, 2-я стр. обложки.

IV Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании». № 3, 3-я стр. обложки.

Вернер В.Д., Сауров А.Н., Резнев А.А. Выбор тактики и стратегия производства изделий электроники (выставка «Продуктроника – 2007», г. Мюнхен, Германия). № 4, с. 80.

Об итогах 15-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2008». № 4, с. 88.

Об итогах Девятой Международной конференции «Исследование и применение нанотрубок» (г. Монтпелье, Франция). № 5, с. 89.

VIII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи. № 5, с. 90.

Памяти Курова Грациана Александровича. № 4, с. 98.

Памяти Мурыгина Виктора Ивановича. № 5, с. 94.